

การวิเคราะห์วงจรกรองผ่านแถบความถี่แชนร์พินไลน์ไมโครสตริป
โดยใช้วิธีสมการอินทิกรัลร่วมกับเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์



นาย ชานูไชย ไทยเจียม

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

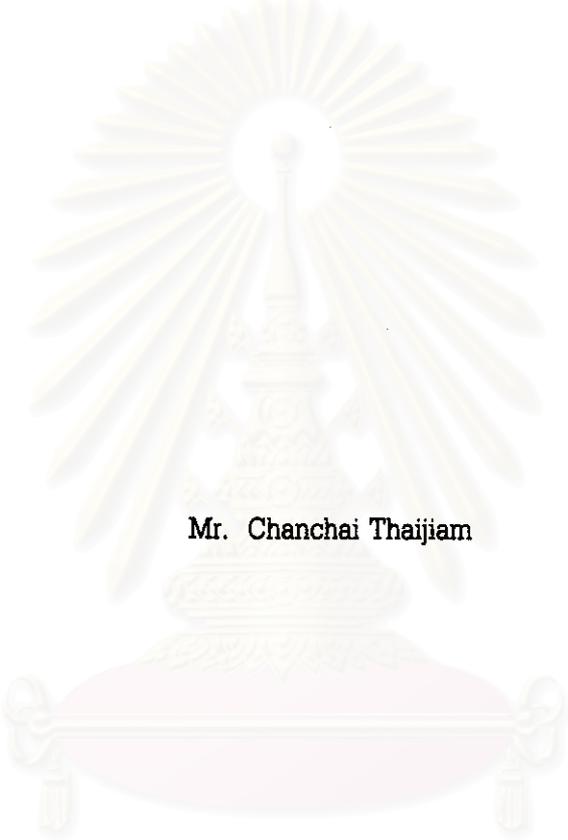
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2540

ISBN 974-639-080-5

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ANALYSIS OF A MICROSTRIP HAIRPIN-LINE BANDPASS FILTER
BY USING INTEGRAL EQUATION METHOD WITH FINITE ELEMENT TECHNIQUE**



Mr. Chanchai Thajiam

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering in Electrical Engineering
Department of Electrical Engineering

Graduate School

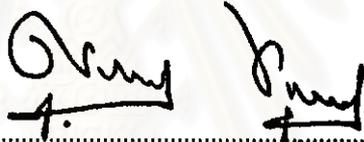
Chulalongkorn University

Academic year 1997

ISBN 974-639-080-5

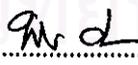
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์วงจรกรองผ่านแถบความถี่แอร์พินไลน์ไมโครสตริป
โดยใช้วิธีสมการอินทิกรัลร่วมกับเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์
โดย นายชาญชัย ไทยเจียม
ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ทับทิม อ่างแก้ว

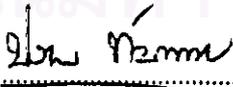
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิต


..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุภาวัฒน์ ชูติวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.นงรงค์ อยู่นอม)


..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทับทิม อ่างแก้ว)


..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ทิมพุม)


..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ไวยัพัตตน)

ชาญชัย ไทยเจียม : การวิเคราะห์วงจรกรองผ่านแถบความถี่แฮร์พินไลน์ไมโครสตริปโดยใช้วิธีสมการอินทิกรัลร่วมกับเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์ (ANALYSIS OF A MICROSTRIP HAIRPIN-LINE BANDPASS FILTER USING INTEGRAL EQUATION METHOD WITH FINITE ELEMENT TECHNIQUE)
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทับทิม อ่างแก้ว , 100 หน้า. ISBN 974-639-080-5.

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วงจรกรองความถี่แบบไมโครสตริป โดยใช้วิธีสมการอินทิกรัลร่วมกับเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์ ในตัวอย่างวงจรกรองผ่านแถบความถี่แฮร์พินไลน์ไมโครสตริป การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์การอินทิกรัลในรูปคีย์แม่เหล็กชนิดเวกเตอร์ คีย์ไฟฟ้าชนิดสเกลาร์ และฟังก์ชันของกรีน ผลเฉลยของสมการอินทิกรัลสามารถหาได้โดยใช้เทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์

ผลการวิเคราะห์แสดงในรูปของค่าพารามิเตอร์การจัดกระจาย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยในอดีต และผลการวิเคราะห์ที่ได้จากโปรแกรมฮิธี ซอฟ รวมถึงผลการวัดที่ได้จากวงจรตัวอย่างที่สร้างขึ้น พบว่ามีค่าสอดคล้องกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีสมการอินทิกรัลร่วมกับเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์ เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์วงจรกรองความถี่แบบไมโครสตริปได้

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า.....
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า.....
ปีการศึกษา2540.....

ลายมือชื่อนิสิตชาญชัย ไทยเจียม.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

#c715484 : MAJOR MAJOR ELECTRICAL ENGINEERING
KEY WORD: HAIRPIN-LINE / INTEGRAL EQUATION / GREEN'S FUNCTION
FINITE ELEMENT
CHANCHAI THAIJIAM : ANALYSIS OF A MICROSTRIP HAIRPIN-LINE
BANDPASS FILTER USING INTEGRAL EQUATION METHOD WITH FINITE
ELEMENT TECHNIQUE
THESIS ADVISOR : ASSOC.PROF. TUPTIM ANGKAEW, Ph.D. 99 pp.
ISBN 974-639-080-5

This thesis has the objective to analyze microstrip filter by using the Integral Equation Method with Finite Element technique via the example of microstrip hairpin-line bandpass filter. The integral equation in forms of magnetic vector potential, electric scalar potential and Green's function is solved by means of Finite Element technique.

The results in scattering parameter show that this method provides results correspond with previous method including results obtained from EE. sof. program and experiment. Therefore, the Integral Equation Method with Finite Element technique can be used to analysis microstip filter as well.



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา.....วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชา.....วิศวกรรมไฟฟ้า
ปีการศึกษา..... 2540

ลายมือชื่อนิสิต..... ชานไชย ไทชยาม
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... Ph.D.
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....



กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทับทิม อ่างแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำแนวทางการวิจัย ตลอดจนให้คำปรึกษารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์เพื่อดำเนินการวิจัยด้วยดี

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุมิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร ที่ได้กรุณาสละเวลาให้คำแนะนำต่าง ๆ ในการทำวิจัย

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ สุวิทย์ นาคพิระยุทธ ที่ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ในห้องปฏิบัติการพื้นฐานไฟฟ้าสื่อสารที่ได้ให้คำแนะนำและกำลังใจด้วยดีเสมอมา

สุดท้าย ไคว่ขอกราบขอบพระคุณบิดา-มารดา ที่ได้เมตตาและให้โอกาสทางการศึกษาแก่ข้าพเจ้าทั้งด้านทุนทรัพย์และกำลังใจด้วยดีเสมอมา

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญรูป.....	ฐ
คำอธิบายศัพท์และสัญลักษณ์.....	ณ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเบื้องต้น.....	1
เค้าโครงของวิทยานิพนธ์.....	4
วัตถุประสงค์.....	4
ขอบเขตของการวิจัย.....	4
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย.....	4
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย.....	5
บทที่ 2 การวิเคราะห์วงจรกรองผ่านแถบความถี่แอร์พินไลน์ไมโครสตริปโดยใช้วิธีสมการอินทิกรัล ร่วมกับเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย.....	6
ความนำ.....	6
แนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีสมการอินทิกรัลร่วมกับเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์.....	7
สมการอินทิกรัลศักย์ผสม.....	9
ฟังก์ชันของกรีน.....	13
คลื่นผิวและระนาบสเปกตรัม.....	14
เทคนิคการอินทิเกรตสำหรับอินทิกรัลซอมเมอร์เฟลด์.....	6
แนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์.....	20
การกระตุ้นของสายป้อนกำลัง.....	24
การกระตุ้นแบบสายแกนร่วม.....	25

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
การกระตุ้นแบบสายป้อน.....	26
การคิดการเชื่อมร่วมระหว่างแผ่นไมโครสตริปที่มีแหล่งกำเนิดกับแผ่นไมโครสตริปที่ไม่มี แหล่งกำเนิดโดยใช้วิธีสมการอินทิกรัลร่วมกับเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์.....	27
การหาค่าพารามิเตอร์การกระจาย.....	29
บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ของงานวิจัย.....	32
ความนำ.....	32
ผลการวิเคราะห์ค่าฟังก์ชันของกรีน.....	32
ผลการวิเคราะห์ค่า S11 และ S21 ของวงกรองผ่านแถบความถี่แฮร์ฟิโนไลน์ไมโครสตริป.....	35
บทที่ 4 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	46
ความนำ.....	46
ผลการทดสอบความถูกต้องของวิธีการที่นำเสนอในตัวอย่างวงกรองผ่านแถบความถี่ แฮร์ฟิโนไลน์ไมโครสตริป.....	46
ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากวิธีสมการอินทิกรัลร่วมกับเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์เปรียบเทียบกับ ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม EE. Sof. และผลการวิเคราะห์จากงานวิจัยของ Randall.....	46
ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากวิธีสมการอินทิกรัลร่วมกับเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์เปรียบเทียบกับ ผลการทดลองวัดวงจรตัวอย่างที่สร้างขึ้น.....	48
ผลการวิเคราะห์ค่าฟังก์ชันของกรีน.....	48
ข้อเสนอแนะ.....	49
รายการอ้างอิง.....	51
ภาคผนวก.....	55
ภาคผนวก ก โดเมนสเปกตรัม.....	56
ภาคผนวก ข การหาฟังก์ชันของกรีน.....	58
ภาคผนวก ค รหัสต้นฉบับที่ได้จากการแปลงแผนภาพของโปรแกรม Libra.....	93

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ง ตารางตัวต่อชนิด SMA	98
ประวัติผู้เขียน	100



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างระบบป้อนสายนำสัญญาณ.....	25
ตารางที่ 3.1 ค่า S_{11} และ S_{21} ของวงจรกรองผ่านแถบความถี่แฮร์ฟินีไมโครสตริป.....	39
ตารางที่ ข.1 ค่าของสัมประสิทธิ์ U , และ L , ในส่วนบนและส่วนล่างของชั้น i ที่มีแหล่งกำเนิด.....	80



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.1 ตัวอย่างวงจรกรองความถี่ไมโครสตริป	3
รูปที่ 2.1 แสดงขั้นตอนการคำนวณของวิธีสมการอินทิกรัลร่วมกับเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์	8
รูปที่ 2.2 ตัวนำหลายชั้นฝังอยู่ในตัวกลางที่เป็นชั้น ๆ ซ้อนกัน	9
รูปที่ 2.3 โครงสร้างไมโครสตริปรูปร่างไม่เจาะจง	12
รูปที่ 2.4 แสดงตำแหน่งของโพลเป็นฟังก์ชันของค่าการสูญเสียของสารไดอิเล็กตริก	15
รูปที่ 2.5 แสดงค่าออร์เมทัลไลน์ของอินทิเกรนด์ของกรีนชนิดสเกลาร์ที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแบบ จุดวางตัวในแนวนอน	17
รูปที่ 2.6 ส่วนจริงของอินทิเกรนด์ของรูปที่ 2.5 ในช่วง $[k_o, k_o \sqrt{\epsilon_r}']$	19
รูปที่ 2.7 ส่วนจริงของอินทิเกรนด์ของรูปที่ 2.5 ในช่วง $[k_o \sqrt{\epsilon_r}', \infty]$	20
รูปที่ 2.8 แสดงโนดของเอลิเมนต์รูปสามเหลี่ยม	22
รูปที่ 2.9 การแบ่งพื้นที่โดเมนรูปสามเหลี่ยมบนแผ่นตัวนำไมโครสตริป	22
รูปที่ 2.10 การกระตุ้นแบบสายแกนร่วม	25
รูปที่ 2.11 แผ่นไมโครสตริปมีการเชื่อมร่วม	28
รูปที่ 2.12 โครงข่ายความไม่ต่อเนื่องสองพอร์ต	30
รูปที่ 3.1 ค่าสัมพันธ์ของฟังก์ชันของกรีนชนิดสเกลาร์	33
รูปที่ 3.2 ค่าเฟสของฟังก์ชันของกรีนชนิดสเกลาร์	34
รูปที่ 3.3 แผนภาพวงจรกรองผ่านแถบความถี่แฮร์ฟิไนน์ไมโครสตริป	35
รูปที่ 3.4 แผนภาพของวงจรกรองผ่านแถบความถี่แฮร์ฟิไนน์ไมโครสตริป	37
รูปที่ 3.5 การแบ่งพื้นผิวของลายวงจรกรองผ่านแถบความถี่แฮร์ฟิไนน์ไมโครสตริปด้วยพื้นที่ เอลิเมนต์รูปสามเหลี่ยมของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์	38
รูปที่ 3.6 ค่า S11 และ S21 ของวงจรกรองผ่านแถบความถี่แฮร์ฟิไนน์ไมโครสตริปจากผลการ วิเคราะห์ของ Randall, EE. Sof. และผลจากวิธีสมการอินทิกรัลร่วมกับเทคนิคไฟไนต์ เอลิเมนต์	39
รูปที่ 3.7 ค่า S11 และ S21 ของวงจรกรองผ่านแถบความถี่แฮร์ฟิไนน์ไมโครสตริปจากผลการ ทดลองของ Randall และผลจากวิธีสมการอินทิกรัลร่วมกับเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์	40

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.8 ค่า S11 และ S21 ของวงจรรองผ่านแถบความถี่แฮร์ฟิไนไลน์ไมโครสตริปจากผลการวิเคราะห์โดยใช้วิธีสมการอินทิกรัลร่วมกับเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับค่าไดอิเล็กตริกสัมพัทธ์เท่ากับ 4.00	41
รูปที่ 3.9 วงจรรองผ่านแถบความถี่แฮร์ฟิไนไลน์ไมโครสตริปที่สร้างขึ้น	42
รูปที่ 3.10 วงจรรองผ่านแถบความถี่แฮร์ฟิไนไลน์ไมโครสตริปและกล่องครอบป้องกันสัญญาณรบกวน	42
รูปที่ 3.11 วงจรผ่านแถบความถี่แฮร์ฟิไนไลน์ไมโครสตริปพร้อมกล่องครอบป้องกันสัญญาณรบกวนรบกวน	42
รูปที่ 3.12 เครื่องวิเคราะห์ข่ายวงจร	43
รูปที่ 3.13 การต่อวงจรรองผ่านแถบความถี่แฮร์ฟิไนไลน์ไมโครสตริปเข้ากับเครื่องวิเคราะห์ข่ายวงจรเพื่อหาค่า VSWR	43
รูปที่ 3.14 ค่า VSWR ของวงจรรองผ่านแถบความถี่แฮร์ฟิไนไลน์ไมโครสตริป	44
รูปที่ 3.15 การต่อวงจรรองผ่านแถบความถี่แฮร์ฟิไนไลน์ไมโครสตริปเข้ากับเครื่องวิเคราะห์ข่ายวงจรเพื่อหาค่า S21	44
รูปที่ 3.16 ค่า S21 ของวงจรรองผ่านแถบความถี่แฮร์ฟิไนไลน์ไมโครสตริป	45
รูปที่ ข.1 แหล่งกำเนิดแบบจุดวางตัวในแนวนอน	68
รูปที่ ข.2 ตัวกลางหลายชั้นมีแหล่งกำเนิดแบบจุดวางอยู่ในชั้น I	70
รูปที่ ข.3 ตัวกลาง 2 ชั้น ปราศจากแหล่งกำเนิด	71
รูปที่ ข.4 ชั้น i มีแหล่งกำเนิดแบบจุดวางตัวในแนวนอน	72
รูปที่ ข.5 แหล่งกำเนิดแบบจุดวางตัวในแนวแกน z	73
รูปที่ ข.6 แหล่งกำเนิดแบบจุดวางตัวในแนวแกน x	76
รูปที่ ข.7 แหล่งกำเนิดแบบจุดวางตัวในแนวแกน y	78
รูปที่ ข.8 ชั้นไดอิเล็กตริกมีแผ่นกราวด์และแหล่งกำเนิดแบบจุดวางตัวที่รอยต่อระหว่างอวกาศว่างกับชั้นไดอิเล็กตริก	84

คำอธิบายศัพท์และสัญลักษณ์

angular velocity	ω	ความเร็วเชิงมุม
area coordinate	L_i	พิกัดพื้นที่
Bessel function of the first kind of order 0	J_0	ฟังก์ชันเบสเซลชนิดที่หนึ่งอันดับศูนย์
Bessel function of the first kind of order 1	J_1	ฟังก์ชันเบสเซลชนิดที่หนึ่งอันดับหนึ่ง
characteristic impedance	Z_0	อิมพีแดนซ์คุณลักษณะ
coupling		การเชื่อมร่วม
delta function	δ	ฟังก์ชันเดลต้า
dielectric substrate		ชั้นไดอิเล็กตริก
dyadic Green 's function	$\overline{\overline{G}}_A$	ฟังก์ชันของกรีนชนิดไดอะดิก
electric charge	q_e	ประจุไฟฟ้า
electric charge density	ρ_e	ความหนาแน่นประจุไฟฟ้า
electric current density	\vec{J}	ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า
electric field	\vec{E}	สนามไฟฟ้า
electric flux density	\vec{D}	ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า
electric vector potential	\vec{F}	ศักย์ไฟฟ้าชนิดเวกเตอร์
finite element method	FEM	วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
frequency	f	ความถี่
incident electric field	\vec{E}'	สนามไฟฟ้าที่ตกกระทบ
loss tangent	$\tan \delta$	แทนเจนต์การสูญเสีย
magnetic flux density	\vec{B}	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
magnetic current density	\vec{M}	ความหนาแน่นกระแสแม่เหล็ก
magnetic field	\vec{H}	สนามแม่เหล็ก
magnetic vector potential	\vec{A}	ศักย์แม่เหล็กชนิดเวกเตอร์
mixed potential integral equation	MPIE	สมการอินทิกรัลของศักย์แม่เหล็กและไฟฟ้า
observation point	\vec{r}	ตำแหน่งของจุดสังเกต
permeability	μ	ค่าความทราบซึมได้
permeability in free space	μ_0	ค่าความทราบซึมได้ในอวกาศว่าง

คำอธิบายศัพท์และสัญลักษณ์ (ต่อ)

permittivity	ϵ	ค่าสภาพยอม
permittivity in free space	ϵ_0	ค่าสภาพยอมในอวกาศว่าง
propagation constant	γ	ค่าคงตัวการแพร่กระจาย
relative permeability	μ_r	ค่าความทราบซึมได้สัมพัทธ์
relative permittivity	ϵ_r	ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์
scalar Green 's function	G_V	ฟังก์ชันของกรีนชนิดสเกลาร์
scalar potential	V	ศักย์ไฟฟ้าชนิดสเกลาร์
scattered electric field	\vec{E}^s	สนามไฟฟ้ากระเจิง
source point	\vec{r}'	ตำแหน่งของแหล่งกำเนิด
speed of light in free space	c_0	ความเร็วของแสงในอวกาศว่าง
surface electric current density	\vec{J}_s	ความหนาแน่นกระแสผิว
thickness of substrate	h	ความหนาของชั้นไดอิเล็กตริก
unknow expansion coefficient	α_j	สัมประสิทธิ์การกระจายที่ไม่ทราบค่า
current vector basis function	\vec{s}_j	ฟังก์ชันพื้นฐานชนิดเวกเตอร์ของกระแส
wave number	k	ค่าคงตัวเลขคลื่น
weighting function	\vec{s}_j	ฟังก์ชันถ่วงน้ำหนัก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย